

2DK35200U 型硅肖特基开关整流二极管

1 特性

芯片采用硅外延平面结构，器件采用 SMD-2 型金属陶瓷封装。
具有正向压降低、正向导通损耗小，体积小、重量轻，可靠性高的特点。
器件的静电放电敏感度为 4000V，SMD-2 型封装的典型重量为 3.4g。



SMD-2 型

2 质量等级及执行标准

G+ G 级：Q/RB1008QZ、QZJ840611；

3 最大额定值

器件额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

型号	I_{FM}^{a} $T_c=110^{\circ}\text{C}$ A	V_{RM} V	V_{RWM} V	$I_{\text{FSM}}^{\text{b}}$ $t_p=8.3\text{ms}$, $T_c=25^{\circ}\text{C}$ A	T_j $^{\circ}\text{C}$	T_{stg} $^{\circ}\text{C}$	$R_{\text{th(jc)}}$ $^{\circ}\text{C/W}$
2DK35200U	35	200	180	280	$-65\sim 150$	$-65\sim 150$	1.0

^a T_c 超过 110°C 时，按 $0.875\text{A}/^{\circ}\text{C}$ 线性地降额。

4 主要电特性

主要电特性 ($T_c=25^{\circ}\text{C}\pm 3^{\circ}\text{C}$) 见表 3。

表 3 主要电特性

序号	符号 (单位)	测试条件	规范值
1	正向压降 V_{FM1}	$T_c=25^{\circ}\text{C}$, $I_{\text{F}}=I_{\text{FM}}$ A	$\leq 0.92\text{V}$
2	正向压降 V_{FM2}	$T_c=-55^{\circ}\text{C}$, $I_{\text{F}}=I_{\text{FM}}$ A	$\leq 1.7\text{V}$
3	反向电流 I_{R1}	$T_c=25^{\circ}\text{C}$, $V_{\text{R}}=0.8 V_{\text{RWM}}$	$\leq 10 \mu\text{A}$
4	反向电流 I_{R2}	$T_c=125^{\circ}\text{C}$, $V_{\text{R}}=0.8 V_{\text{RWM}}$	$\leq 1\text{mA}$

5 特性曲线

5.1 不同温度、不同电压下的反向电流曲线

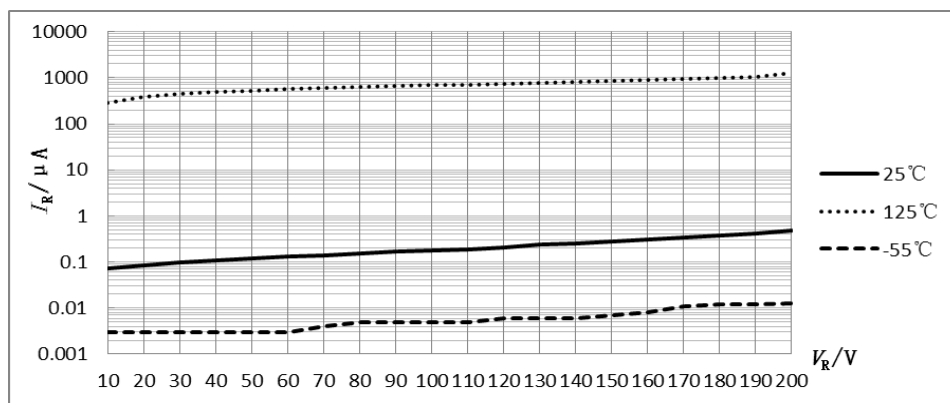


图 1 $I_{\text{R}}-V_{\text{R}}$ 特性曲线



5.2 不同温度、不同电流下的正向电压曲线

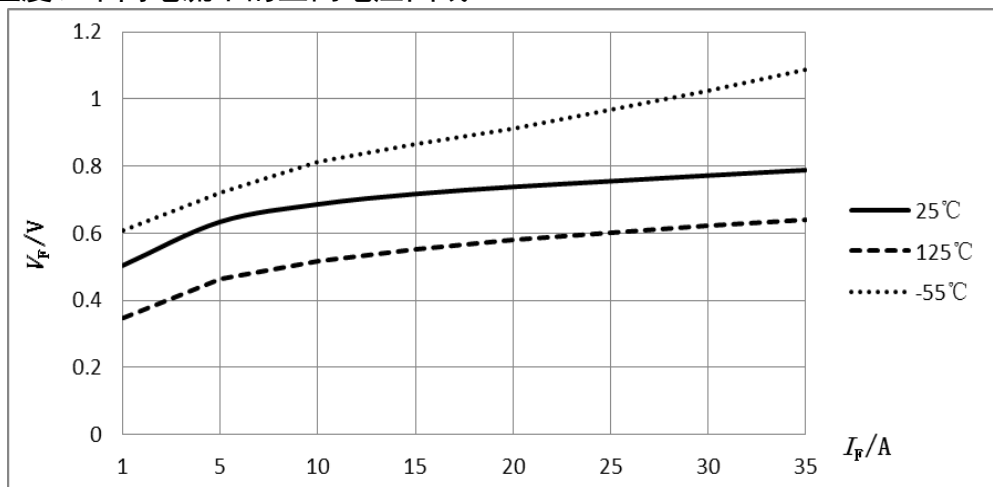
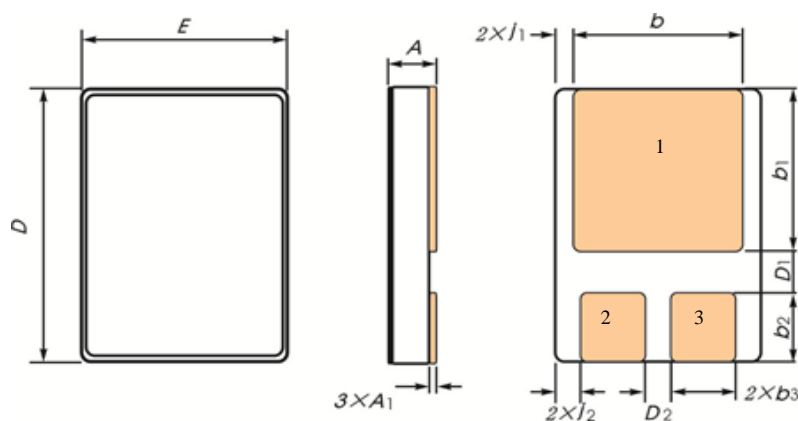


图 2 V_F — I_F 特性曲线

6 外观尺寸（SMD-2 型）



引出端电极：1-阴极 2-阳极 3-阳极

单位为毫米

尺寸符号	数 值		尺寸符号	数 值	
	最 小	最 大		最 小	最 大
A	—	3.58	D	17.40	17.65
A_1	0.25	0.51	D_1	0.89	—
b	11.05	11.30	D_2	1.27	—
b_1	11.94	12.19	E	13.21	13.46
b_2	3.87	4.11	j_1	0.96	1.21
b_3	—	3.58	j_2	1.72	1.97

图 3 SMD-2 外形尺寸